

Testsystem für gegurtete Halbleiter



Technische Daten

Prüfspannung:
0,5 - 75 V Genauigkeit: 0,05%

Pulsstrom: 1 - 80 A
Pulsdauer: 20 - 200 us

Messbereich Spannung:
2 - 75 V Genauigkeit: 0,05%

Messbereich Strom:
1 nA - 100 mA 0,1%

Testfolge und Prüfparameter
programmierbar

Protokollierung und Statistik
in der Basisversion enthalten

Beschreibung:

Dieses Testsystem dient zur Überprüfung, Belastung (Stresstest) und Selektion von gegurteten Zenerdioden.

Die Dioden werden auf die Parameter Zenerspannung, Leckstrom und Impulsfestigkeit getestet. Der Impulstest erfolgt mit einem geregelten Leistungsimpuls mit einer Dauer von 20us bis 200us und einem programmierbaren Strom bis zu 80 Ampere.

Die Messung der gegurteten Bauteile erfolgt in 2 separaten Kontaktierstationen, um eine thermische Beeinflussung der Messung durch die Leistungsimpulse zu vermeiden.

Die Prüflinge können je nach Testergebnis wahlweise markiert oder aus dem Gurt ausgestanzt werden.

Das Handlingssystem ermöglicht die Anpassung auf unterschiedliche Gurtbreiten sowie Bauteilabstände und erlaubt das schnelle Umspulen der Bauteilrollen. Das Testsystem ist bestens geeignet für die Wareneingangskontrolle sowie die Fertigung.



GESELLSCHAFT FÜR
MESS- UND SYSTEM-
TECHNIK mbH

Max-Planck-Str. 5 • 78549 Spaichingen
Tel. 07424 95900 • Fax 07424 9590-19

www.GMS-Messtechnik.de